

## 武汉高德红外股份有限公司

### 关于碲镉汞制冷型红外焦平面阵列探测器项目

#### 通过科技成果评价的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，国家技术转移中部中心组织行业专家对武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）研制的“1280×1024 规模、12μ m 像元尺寸的碲镉汞制冷型红外焦平面阵列探测器”项目进行了评价。专家组听取了项目的研制成果汇报、技术报告、应用报告及经济效益和社会效益分析报告，观看了成果演示，经过质询和讨论，评价专家组一致同意公司该碲镉汞制冷型红外焦平面阵列探测器项目通过科技成果评价。

#### 一、评价意见

评价专家组认为：公司提供的资料齐全、完整，符合评价要求；高德公司研制的 1280×1024 规模、12μ m 像元尺寸的碲镉汞制冷型红外焦平面阵列探测器芯片，经华东电子测量仪器研究所光电计量校准中心测试，主要技术性能指标达到或优于国际同类产品指标；该项目是典型的高新技术军民两用产品，具有良好的社会效益和经济效益前景。

评价专家组一致认为该成果整体达到国际先进水平，该项成果具备红外探测器产业化的基础，建议进一步加快延伸开发及推广应用。

#### 二、技术突破的意义及对公司未来影响

本次公司研制的 1280×1024 规模、12μ m 像元尺寸的碲镉汞中波制冷型红外焦平面阵列探测器芯片项目的评审通过，是公司继掌握非制冷 1280×1024@12μ m 探测器芯片研制技术后，在制冷型大规模探测器芯片领域取得的又一重大突破。

1、公司研制的 1280×1024 规模、12μ m 像元尺寸的制冷型探测器芯片使用的敏感材料、最大面阵及最小像元等指标都代表着我国制冷型红外探测器芯片研发与制造的最高水平，大幅提升了红外热像仪系统的空间分辨率，提高了探测距

离、识别距离，大力推动了红外焦平面探测器芯片技术朝大面阵规格、小像元尺寸方向发展，为我国关键基础材料和核心元器件技术的快速发展提供重要保障。

2、结合公司现已建成的制冷探测器芯片批产线优势，该碲镉汞制冷型红外焦平面阵列探测器芯片的研制成功将大幅度提升高端红外热成像产品性能指标，为我国大面阵、小像元碲镉汞红外焦平面探测器芯片产业化扫除障碍，打破红外成像系统中高端核心芯片的技术垄断、实现进口替代，有力促进了我国高端碲镉汞材料和探测器芯片产业核心能力的提升。

### 三、风险提示

公司募集资金投资项目建设的制冷型碲镉汞及II类超晶格红外探测器产业化项目现正处于产业化建设阶段，经济效益需要一定时间才能体现。公司将根据制冷型碲镉汞红外探测器产业化项目建设进展情况及时进行公告，公司提示投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇一九年六月三日